# 规格参数

### 概述

霍尔效应测试系统是集成Keithley2400/2600系列高精度源表和Semishare polaris高低温平台,采用范德堡尔法则设计,应用于高精度的测量半导体材料的载流子类型(P型/N型)、载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数等参数,能够适用于Si、SiGe、SiC、GaAs、InGaAs、InP、GaN等半导体材料。

#### 应用方向

Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP环境下应用于Si, SiGe, SiC, ZnO, GaAs, InGaAs, InP, GaN, ITO等所有半导体薄膜(P型和N型)

### 客户对象

科研院校/研究所实验室/芯片设计公司/晶圆厂/封测厂/面板厂等领域

## 产品特点

- 业界领先的keithley测试平台
- 超高精度源表,实现精准测量
- 模块化设计,性能稳定维护简便
- 丰富的软件功能,操作便捷灵活
- 可视化界面,数据分析清晰明了
- 高低温变温环境,有效实现可靠性测试



<b>型</b> 号	HALL	
软件操作环境	Windows98/ME/2000/NT/XP环境下	
参数	有效电流输出范围	6nA~100mA
	有效电压测量范围	-5~5V
	载流子浓度concentration(/cm3)	107–1021
	迁移率Mobility(cm2/Vs)	1~107
	电阻率Resistivity(Ohm.cm)	10-4-107
	A/B ratio	OK
	RHD(cm3/C)	OK
	RHC(cm3/C)	OK
	RH(cm3/C)	OK
	Sheet Resistance(Ohm)	OK
	温度	温度(K):常温和77K两个温度点
		Option:77K~500K,0.1摄氏度精度,可通过程序设定
仪器尺寸和重量	主机尺寸	89mm高×213mm宽×370mm长
	重量	3.21kg
工作环境要求	0°-50°C, 70%R.H.	
存储环境要求	−25°C to 65°C	
范德堡尔法则终端转换器	200×120×110 mm (W×H×D)	
净重	7.7千克	
测量材料	Si,SiGe,SiC,ZnO,GaAs,InGaAs,InP,GaN,ITO等所有半导体薄膜(P型和N型);	

19 50